

Silicon Diode

BA204

50V / 200mA

DATASHEET

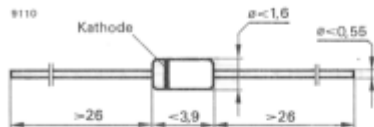
OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BA 204**Silizium-Epitaxial-Planar-Diode**

Anwendungen: Allgemein

Abmessungen in mm



Standard Glasgehäuse
54 A 2 DIN 41 880
JEDEC DO 35
Gewicht max. 0,15 g

Bestempfung: Klartext

Absolute Grenzdaten

Periodische Spitzensperrspannung	U_{RRM}	60	V
Sperrspannung	U_R	50	V
Stoßdurchlaßstrom $t_p = 1 \mu s$	I_{FSM}	2	A
Periodischer Durchlaßspitzenstrom	I_{FRM}	450	mA
Durchlaßstrom	I_F	200	mA
Durchlaßstrom, Mittelwert	I_{FAV}	150	mA
Sperrschichttemperatur	T_j	200	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 65....+ 200	°C

Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung $l = 4 \text{ mm}, T_L = \text{konstant}$	R_{thJA}	350	K/W
--	------------	-----	-----

Kenngroßen $T_j = 25 \text{ °C}$, falls nicht anders angegeben

		Min.	Typ.	Max.	
Durchlaßspannung $I_F = 100 \text{ mA}$	$U_F^{1)}$			1	V
Sperrstrom $U_R = 30 \text{ V}$	I_R			100	nA
$U_R = 30 \text{ V}, T_j = 150 \text{ °C}$	I_R			100	μA
Durchbruchspannung $I_R = 1 \mu A$	$U_{(BR)}^{1)}$	50			V
Diodenkapazität $U_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$	C_D			5	pF
Rückwärtserholzeit $I_F = I_R = 10 \text{ mA}, i_R = 1 \text{ mA}$	t_{rr}			10	ns

¹⁾ $\frac{t_p}{T} = 0,01, t_p = 0,3 \text{ ms}$

BA 204

